맞춤형 Ptfe 반도체 웨이퍼 세정 바스켓 내식성 저배경 실험실 랙

품목 번호: PL-CP267

소개

당사의 맞춤형 PTFE 세정 바스켓으로 반도체 제조에서 탁월한 순도를 달성하십시오. 극한의 내화학성과 낮은 배경 간섭을 위해 설계된 이 내구성 있는 랙은 중요한 고순도 실험실 환경에서 효율적인 웨이퍼 처리, 신속한 배수 및 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
RCA 세정 공정	실리콘 웨이퍼에서 유기 잔류물 및 금속 오염 물질을 제거하기 위해 SC-1 및 SC-2 시퀀스 중에 사용됩니다.	초순수, 저용출 소재 표면으로 인해 재오염을 방지합니다.
피라냐(Piranha) 식각	감광액 제거를 위해 황산과 과산화수소 혼합물에서 웨이퍼를 처리합니다.	구조적 열화 없이 공격적인 산화 환경에 대한 탁월한 내성을 가집니다.
불산(HF) 침지	농축 또는 완충 HF 용액을 사용하여 실리콘 기판에서 자연 산화막을 제거합니다.	HF 공격에 대한 완전한 면역성으로 장비의 장기적인 생존과 공정 순도를 보장합니다.
CMP 후 린싱	화학 기계적 연마(CMP) 후 슬러리 입자와 화학 물질을 제거하기 위해 웨이퍼를 세정합니다.	신속한 배수 및 비점착 특성으로 슬러리 입자가 바스켓에 달라붙는 것을 방지합니다.
포토리소그래피 현상	감광액 층의 현상 및 박리 중에 기판을 지지합니다.	높은 치수 안정성으로 중요한 리소그래피 단계에서 정밀한 정렬 및 취급을 보장합니다.
미량 분석 준비	ICP-MS 및 기타 고감도 분석 기술에 사용되는 실험 기구 및 용기를 세정합니다.	매우 낮은 배경 수준으로 미량 금속 불순물 검출 시 최고의 정확도를 보장합니다.
GaAs 웨이퍼 처리	특수 식각 및 린스 사이클을 통해 화합물 반도체 웨이퍼를 처리합니다.	부드러운 지지 구조로 부서지기 쉬운 화합물 반도체 재료의 파손을 방지합니다.
초음파 세정	고주파 음향 세정 사이클 동안 침수된 캐리어 역할을 합니다.	웨이퍼가 탱크와 기계적으로 접촉하지 않도록 보호하면서 초음파 에너지를 효율적으로 전달합니다.

특징	PL-CP267 세부 사양
모델 식별자	PL-CP267
주요 재질	고순도 버진 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
제조 공정	100% 정밀 CNC 가공 (사출 성형 잔류물 없음)
내화학성	HF, H_2SO_4, HNO_3, HCl, KOH 및 유기 용매에 대한 완전한 내성
온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
표면 마감	입자 포착을 최소화하는 매끄럽고 낮은 다공성 마감
구성 옵션	완전 맞춤 가능 (웨이퍼 크기, 슬롯 너비, 슬롯 피치, 핸들 디자인)
웨이퍼 호환성	2", 3", 4", 6", 8", 12" 웨이퍼 또는 맞춤형 치수에 적합
배수 설계	최적화된 유체 유출을 위해 V-바닥 또는 U-바닥 슬롯 프로파일 사용 가능
배경 수준	sub-ppb 금속 불순물 요구 사항을 위해 특수 처리됨